# 科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 5 月 19 日現在

機関番号: 12501 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2011~2013 課題番号:23560387

研究課題名(和文)ダイヤモンドを使ったRF-SAWフィルタの研究

研究課題名(英文) Study on a RF-SAW filter made of diamond

研究代表者

藤井 知(FUJII, SATOSHI)

千葉大学・産学連携・知的財産機構・特任教授

研究者番号:30598933

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円、(間接経費) 1,200,000円

研究成果の概要(和文): ダイヤモンドはその物質的な性質からGHz領域における高周波SAWが実現出来る材料として知られる。しかしながら、多結晶ダイヤモンド薄膜を使ったSAWフィルタでは、水晶やLiNbO3の材料に比べ、ダイヤモンドSAWの伝搬損失が大きく、RF-SAWフィルタでは大きな問題となる。そこで、単結晶ダイヤモンドを用い 1 ポートSAW共振子の試作を続けたところ、5GHzにてQが8346と極めて大きな値を得ることが出来、伝搬損失も波長当たり0.004dBとすることが出来た。また、fQ 積も10 ^ 13と十分大きな値を示した。これらの値はSHF帯におけるRF-SAWフィルタの実現の可能性を示している。

研究成果の概要(英文): Diamond has the highest known SAW phase velocity, sufficient for applications in the gigahertz range. In addition, diamond is also free from rare earth and rare metal materials. Although numerous studies have demonstrated SAW devices on polycrystalline diamond thin films, all of these devices have a much larger propagation loss than single-crystal materials such as LiNbO3. Hence, we fabricated and characterized one-port SAW resonators on single-crystal diamond to identify and minimize sources of propagation loss. A series of one-port resonators were fabricated, and their characteristics were measured. The best performing device using a diamond single crystal exhibited a resonance frequency of 5.2 GHz, and the equivalent circuit model gave a quality factor of 8346. Thus, the propagation loss was found to be only 0.004 dB/wavelength. The result shows that single-crystal diamond SAW resonators have great potential for u se in RF-filters as sustainable SAW devices.

研究分野: 工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学・電子デバイス・電子機器

キーワード: 弾性表面波 ダイヤモンド

#### 1.研究開始当初の背景

全ての材料の中、ダイヤモンドは最も大き いヤング率を持つことが知られている。ダイ ヤモンド使い、弾性表面波素子を形成すると、 従来、水晶や LiNbO3 などの材料に比較し、 容易に高周波 SAW フィルタが実現する。ダ イヤモンドを使った SAW デバイスの開発は、 東北大山之内らが初めて発表し、その後、申 請者らにより、実用的なダイヤモンド SAW フィルタが完成した。シリコン基板上に、主 に弾性波の媒体となるダイヤモンド薄膜を 形成し、その上に圧電体を形成する。その圧 電体に電気信号を与えるための電極パター ンを作製する。最上層膜は温度変化に対し、 ダイヤモンドや圧電体と逆の弾性定数を持 つ酸化シリコンを温度補償膜として形成す る。これまで得られた特徴は、動作周波数は 10GHz まで可能であり、かつ、水晶 SAW フ ィルタより優れた温度特性を持つことが示 された。直近の研究成果では、圧電体薄膜と して窒化アルミニウムを用いると、5GHz以 上にてフィルタ特性が著しく向上し、かつ温 度変化に対し水晶 SAW フィルタより小さい 周波数偏差を実現することが出来、ダイヤモ ンドSAW フィルタの GHz 帯共振子のポテン シャルを示すことが出来た。しかしながら、 高周波 SAW 共振子の開発が進んでも、次世 代無線通信システム全体の革新に繋がらな い。そこで、ダイヤモンドの高い耐電力性を 活かした急峻かつ広い通過帯域幅を持つ SAW フィルタの研究を行う。実用的な特性 が実現すると、基地局内の RF フィルタの小 型化が出来、ユビキタスネットワークの構築 に貢献出来る。

# 2.研究の目的

ダイヤモンド SAW フィルタの研究は、気 相合成法を用いて形成された多結晶ダイヤ モンドを中心に研究がされてきた。そのため、 多結晶ダイヤモンドに起因する、圧電体の材 料の制約や、その配向性の限界、欠陥が多い ことによる材料自身の損失など、様々な要因 により、SAW フィルタの特性の限界があっ た。単結晶ダイヤモンドの大型基板の可能性 が見えてきたことを踏まえ、ダイヤモンドを 用いた SAW フィルタの可能性の限界を示し たい。具体的にはダイヤモンド SAW の低ロス 及び高 Q 化、10W 以上の耐電力性、 電気機 械結合係数が 9%以上と大きい圧電体薄膜の ダイヤモンド上への形成を目的とし、RF-SAW フィルタの研究を進める。

# 3.研究の方法

研究期間の前半は、単結晶ダイヤモンド基板に、AINなど圧電薄膜を形成しSAWフィルタの設計と試作を行い、高いQが得られることを示す。また、GHz帯における耐電力評価装置を構築し、試作したダイヤモンドSAWの耐電力性評価を行う。研究期間の後半は、ターゲット材料が2つ以上配置出来るようス

パッタ装置の構築を行い、単結晶ダイヤモンド上へ $Sc_xAI_{1-x}N$ などの圧電体薄膜の形成を試み、広帯域フィルタの試作及び耐電力性の試験を行う。

(1)低挿入損失及び広帯域 SAW フィルタの構造と電極設計

有限要素法を用い、電極及び圧電体薄膜 (AIN) 膜厚の最適化を行い、電気機械結合係数が大きくなる膜厚の組み合わせ(構造最適化)を見出す。その後、挿入損失が小さくかつ通過帯域幅が大きくなるように、弾性表面波のモード結合理論を元に電極設計を行う。また、大きい電機械結合係数を持つ圧電体薄膜を用いた設計も行う。

(2)単結晶ダイヤモンドを用いた SAW の試作 単結晶ダイヤモンド上に、前述の構造及び 電極設計に基づき、圧電薄膜 (AIN)を形成 し、電極を作製し、SAW フィルタを試作する。 比較のため、多結晶ダイヤモンド基板を用い た SAW フィルタも、試作する。

#### (3) 耐電力評価設備の構築と評価

10W 以上の信号出力を持つ評価システムを構築し、ネットワークアナライザにより、SAW フィルタの劣化をチェックする。同時に、サーモビュアを使い、温度分布を測定し、耐電力のメカニズムを探る。

(4)電気機械結合係数の大きい薄膜材料のダイヤモンド上への形成と SAW フィルタ試作評価

ECR スパッタ等の装置を 2 種類のターゲットが配置出来るよう設備の改造を行う。ダイヤモンド上へ、Sc<sub>x</sub>AI<sub>1-x</sub>N や LiNbO<sub>3</sub> などの圧電薄膜の形成を検討する。基板は、ヘテロエピタキシャル成長しやすい(111)面を中心とした単結晶ダイヤモンドを用い、オフ角も含め成長条件を実験により見出す。

# (5) 研究のまとめと評価

一連の試作と評価結果から、ダイヤモンドの高い熱伝導性や高い弾性定数を活かした、10W以上の大きな耐電力性を持つ広帯域 SAWフィルタ(RF-SAWフィルタ)の実現性について議論を行い、ダイヤモンド SAW の工学的な特徴を明らかにし、本研究を統括する。

# 4.研究成果

AIN/ダイヤモンド構造における SAW 伝搬 特性の解析を行った。その解析結果を、図 1 と図 2 に示す。図 1 は位相速度(Vp) 図 2 は電気機械結合係数 (K<sup>2</sup>) である。膜厚 (H) )により規格化した H/ を用いた。 は波長( この解析結果から、膜厚が 0.35~0.60 の範 囲における 2nd モードのセザワ波は、他のモ ードに比べ、速度分散性が小さく、K2 が大き い特徴を持つことが分かる。本研究では、膜 厚 0.35 を選び、1ポート共振子の作製を行 った。1 ポート SAW 共振子の電極設計は、SAW を励振させる IDT 電極の両端に、SAW を閉じ 込める反射器が配置される。IDT や反射器の ように、伝搬路に周期的な摂動を与えるとブ ラッグ反射が生じ、伝搬定数が複素数となる

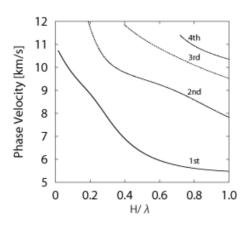


図 1 位相速度 (Vp)

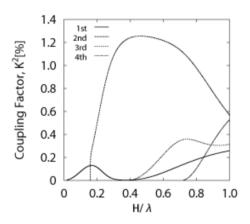


図 2 電気機械結合係数 (K²)

阻止域が形成される。この阻止域では、SAW の振幅が指数関数的に減衰するため、反射器 として利用できる。

IDT と反射器が等周期の場合、阻止域下端より若干低い周波数で共振するため、反射器も阻止域から外れ、反射量が低下する。一方、IDT 部の阻止域端が反射器の阻止域の中心にくるように反射器周期を調整すれば、良好な閉じ込めが実現できる。ただし、高次モードが発生しやすくなるため、一般には IDT と反射器の周期に大きな差を与えられない。本論文では、反射器周期を IDT 周期の-1.5%とした

単結晶ダイヤモンドを用い AIN/Diamond 構造を形成し、1ポート SAW 共振子を作製した。また、プラズマ CVD 法による大型単結晶ダイヤモンドや多結晶ダイヤモンドを比較のために作製した。その最も特性の良かった共振子は高圧合成法により得られた Ib 単結晶ダイヤモンドを使ったものであり、そのアドミタンス特性を図 3 に示す。基板材料の比較を表 1 に示す。この測定データに対し、マンス特性を図 3 に示す。基板材料の比較を表 1 に示す。この測定データに対し、フィッティングすることにより、共振子のクスなどを求めた。共振子の周波数 f,はコンダクタンスのピークとし、伝搬損失は電極抵抗を除いた Q より算出した。

表1今回の試作した1ポート共振子の結果

基板材料	f <sub>r</sub> (GHz)	Q	$\alpha$ (dB/ $\lambda$ )
微粒多結晶 ダイヤ	5.20	2,220	0.015
単結晶			
ダイヤ Ib	5.27	2,954	0.012
(110)			
単結晶			
ダイヤ Ib	5.23	8,346	0.004
(100)			
単結晶ダイ			
ヤモンド	5.23	5,500	0.005
CVD(100)			

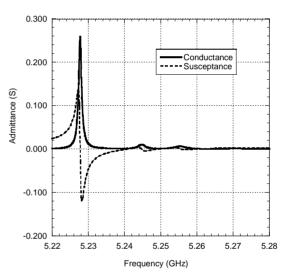


図3単結晶ダイヤモンドのアドミタンス特性

表面状態の良い高圧高温合成法で作製した(100)面の単結晶ダイヤモンドを用いることで Q は 8,346 となり、f・Q 積は 4.4×10<sup>13</sup> に達した。この値はサファイヤ基板を利用した高次モードバルク振動子で実現されている 10<sup>14</sup> には届かないものの、スプリアスは少なく、SAW 共振子としては非常に大きな値である。また、CVD 法によって合成された単にある。また、CVD 法によって合成された単には、5,500 となり、高圧高温合成法とほぼ遜色ない結果となった。この差は電極形成プロセスなどの差と考えている。

本論文では、1 ポート SAW 共振子の基板に 高圧高温合成法及びプラズマ CVD 法によって 作製された単結晶ダイヤモンドを用い、多結 晶ダイヤモンドを用いた場合との比較を行った。基板上に AIN を c 軸優先配向させるこ とができ、結晶性に殆ど差がない膜ができた。 ただし、表面の平坦性はダイヤモンドの研磨 状態により今のところ、(100)面のダイヤモ

ンド表面が最も平坦であり、同時に、AIN も 平坦な膜が得られている。次に、 IDT/AIN/diamond 構造の1ポート共振子の試 作および、測定を行った。多結晶ダイヤモン ド基板に代わり、単結晶ダイヤモンド基板を 用いることで、伝搬損失は 0.037 dB/λ から  $0.004dB/\lambda$  にまで低減させることができた。 その差分は 0.033 dB/λであり、結晶粒界での 散乱損と表面の平坦性がデバイス性能に大 きく影響することが明らかになった。また、 Q は 8,346 となり、f・Q 積は 4.4×10<sup>13</sup> に達 した。同時に、連携研究者らにより、Sc、Ala、N の圧電薄膜を用いたダイヤモンドを使った 男性表面波素子は、電気機械結合係数が 6% 以上持つことが示された。耐電力評価につい ては、素子作製と評価がクリーンルームでは ないところで行ったため、パーティクルの影 響が大きく十分な測定が出来なかった。しか し、伝搬損失が大きく低減したことにより、 ダイヤモンドを使った SAW デバイスが 5GHz 領域における高安定発振器用共振子や RF-SAW フィルタとしてのポテンシャルを持つこ とが示された。今後、さらに、RF-SAW フィル タの可能性について研究を進めていく。

### 5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

### 〔雑誌論文〕(計 3件)

- 1. <u>S. Fujii</u>, T. Odawara, H. Yamada, <u>T. Omori, K. Hashimoto</u>, H. Torii, H. Umezawa, and S. Shikata, "Low propagation loss in a one-port SAW resonator fabricated on single-crystal diamond for super high frequency applications", IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol.60, pp.986-992, 2013 [查読有]
- 2. <u>S. Fujii</u>, and C. Jian, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol.59, pp.2758-2764, 2012[査読有]
- 3. <u>S. Fujii</u>, "High frequency surface acoustic wave filter based on diamond thin film", Phys. Status Solidi A 208, No. 5, pp.1072-1077, 2011[査読有]

#### [学会発表](計 6件)

- 1. "Low propagation loss in a one-port resonator fabricated on single-crystal diamond", S. Fujii, H. Yamada, T. Omori, K. Hashimoto, H. Torii, H. Umezawa and S. Shikata, IEEE International Microwave Symposium, TU1D-6-1~3, 2013[米国、シアトル][査読有]
- 2. <u>S. Fujii</u>, H. Yamada, <u>T. Omori</u>, K. Hashimoto, H. Torii, H. Umezawa, and S. Shikata, "High Frequency SAW Devices Using a Single Crystal Diamond," Proc.

2012 Int'l Symp. on Acoustic Wave Devices for Future Mobile Comm. Systems, pp.119-124, 2012[千葉市]

- 3. **S. Fujii**, H. Yamada, <u>T. Omori</u>, <u>K. Hashimoto</u>, H. Torii, H. Umezawa and S. Shikata, "Study on a one-port SAW resonator using a single crystal diamond", International Union of Material Research Societies- International Conference on Electronic Materials, Yokohama, 2012[横浜市][査読有]
- 4. <u>S. Fujii</u>, T. Odawara, <u>T. Omori</u>, <u>K. Hashimoto</u>, H. Torii, H. Umezawa, and S. Shikata, IEEE Ultrasonic Symposium, 2011[査読有]
- 5. **藤井知**、小田原達矢、山田晴也、<u>大森達</u>也、<u>橋本研也</u>、鳥居博典、梅澤仁、鹿田真一、 "単結晶ダイヤモンドを使った 1 ポート SAW 共振子"、日本学術振興会 弾性波素子技術第 150 委員会 第 121 回研究会資料[東京] 6. 山田晴也、**藤井知**、小田原達矢、<u>大森達</u>也、<u>橋本研也</u>、鳥居博典、梅澤仁 鹿田真一、"単結晶ダイヤモンドを用いた高周波 SAW 共振子"、ダイヤモンドシンポジウム、2011 年[つくば市]

[図書](計 0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計 0件)

取得状況(計 0件)

〔その他〕 なし

6.研究組織

(1)研究代表者

藤井 知(FUJII SATOSHI)

千葉大学 産学連携・知的財産機構

特任教授 研究者番号:30598933

(2)連携研究者

千葉大学 工学研究科・教授

橋本 研也(HASHIMOTO KENYA)

研究者番号:90134353

(3)連携研究者

千葉大学 工学研究科・助教

大森 達也 (OMORI TATSUYA)

研究者番号:60302527